原始太陽系星雲における 酸素同位体比のグローバル進化

福井隆 倉本 圭 北海道大学・大学院理学院・宇宙理学専攻

星屑から惑星まで

ダストの付着成長・沈殿 円盤内の物質輸送 凝縮可能物質の濃集 微惑星の形成

重元素の合成・放出 プレソーラー粒子の形成

光化学過程による酸素同位体分別 氷, 有機分子の形成 分子雲コアの収縮・恒星と円盤の形成

原始惑星の形成 ジャイアントインパクト

惑星形成の標準モデル

- ダストの付着成長
- 中心面への沈殿,ダスト層形成
 snow line 以遠では氷が存在
 重力不安定による微惑星形成
 微惑星同士の合体成長
 内側ほど早く成長
- 巨大惑星のガス捕獲
 - snow line 以遠で巨大コア
- 星雲ガスの散逸
 - 海王星はガス捕獲に間に合わず



コンドライトとは?

- 太陽系最古の固体物質(の1つ) 小惑星(微惑星の生残り)のかけら • 軌道計算,分光観測から • 母天体が小さいため,形成後の分化 が進んでいない. ● コンドライトの構成物質 • コンドリュール mm サイズの球粒. 自由空間中 でメルトが固化して形成. ● 難揮発性包有物 (CAI, AOA)
 - 太陽組成の下では最も高温で凝縮する鉱物.
 - Fe-Ni 合金
 - マトリックス





小惑星 Itokawa (組成は LL コンドライトに類似)

惑星形成の初期条件への制約

- Hayashi et al. (1985) 他 ...
 現在の太陽系から復元
- Hartmann et al. (2005) 他 ...
 実際に観測から
- Ruden & Pollack (1991) 他 ...
 α-model を用いた力学理論
- 北大グループ, Ciesla, Gail ...
 化学・同位体組成からの制約



酸素同位体比の重要性

なぜ酸素か?

- 豊富な元素 (全元素中 3 番目, 固 体中では最多.)
- 日盤環境下において,固・気
 (・液)各相に存在.
- 形成される鉱物組成が酸素分圧 に強く依存.
- なぜ同位体比か?
 - 酸素は3つの安定同位体を持つ
 - 通常の分別過程と混合過程が
 区別可能,物質進化の履歴を
 詳しく読み解くことが可能.



コンドライト原物質の酸素同位体不均質

- 傾き1の直線上に分布.
 - ¹⁶O-rich, ^{17,18}O-rich な 2 種のリザーバが 存在, 量比を変えて混合し形成
- CAI (¹⁶O-rich), コンドリュール (^{17,18}O-rich)
 ~ 40 ‰ の差 (Clayton, 1993)
- 典型的には CAI の方が 2.5 Myr 程古い.
 (Amelin et al., 2002)
 - 円盤酸素同位体組成の大局的進化
- コンドリュール・惑星物質間の組成差は 10 ‰ 程度. (Clayton, 1993)
- 形成期間は > 1 Myr (倉橋, 2005)
 - コンドリュール形成期 (以降)の円盤は 酸素同位体的にかなり均質



先行研究

- Yurimoto & Kuramoto (2004)
 - 2種のリザーバ形成
 - 分子雲における光化学過程.
 - CO (¹⁶O-rich) ... 全域で気相に存在. H₂O (^{17,18}O-rich)
 - ... snow line を境に固相→気相
 - 量比を変えて混合する過程
 - ガス-ダスト分別による H₂O 濃集.
- 問題点 ... 多くの単純化
 - 各進化段階における snapshot.
 - 分析値・年代学との比較が困難.
 - 水蒸気のみ, 準定常状態, mm サイズのダストを仮定.

YK04 の H₂O 濃集モデル



CO ... H₂ gas に対する濃度は円盤全域で一定. H₂O ... snow line を挟んで輸送速度が減少. H₂ gas に対する濃度増加.

円盤降着が減衰するとダスト/ガス速度比が 増加, 円盤内側領域の水蒸気の濃集度も増加.

本研究では…

- 主要な酸素キャリアーの円盤内輸送をシミュレート,
 それが酸素同位体組成に与える影響を再検討.
 - H₂O, シリケイトの固・気両相の輸送過程の計算.
 - 衝突破壊による最大ダストサイズの半解析的な見積り.
 - 降着の減衰に伴うガス-ダスト分別の時間変化の計算.
- CAI やコンドリュールの酸素同位体組成の分析値や 年代学に基づき,その形成シナリオについて議論.
 制約条件: 2.5 Myr で 40 ‰ 程度 δ^{17,18}O が変化. コンドリュール形成期の組成不均質小.

観測に基づく円盤モデル

• 降着率の時間変化

• Hartmann et al. (1998) $\dot{M}_{\rm disk}(t) = \left(\frac{t}{10^6 {\rm yr}}\right)^{-\eta} \times 10^{-8} M_{\odot}/{\rm yr}$

- 観測からの制約:1.5 < η < 2.8. ダストの観測は 1.5 を支持.
- 計算開始時刻:10⁻⁷ M_{solar} / yr の時点.
- ガス面密度 … 相似的な進化を仮定. $\Sigma_{g} = \Sigma_{g,0} \times \left(\frac{r}{1 \text{AU}}\right)^{-q}$
 - CTTSの観測から, 質量 0.001–0.1 M_{solar}, 半径 ~ 100 AU, q = 1.0.
 - 降着による質量減少は考慮. $M_{\text{disk}}(t) = M_{\text{disk}}(0) \int_{0}^{t} \dot{M}_{\text{disk}} dt$
- 中心面温度分布 ... 粘性散逸による加熱が支配
 - 降着で解放される重力エネルギーにより加熱.
 - 吸収係数: 1 cm² g⁻¹ (Miyake & Nakagawa, 1993)

● 酸素キャリアー濃度変化は円盤構造に影響を与えないと仮定.

• e.g., 光学的厚さの時間変化なし

分子種iの固・気相における輸送方程式

$$\frac{\partial C_{i,\text{sol}}}{\partial t} = -v_{\text{d},r} \frac{\partial C_{i,\text{sol}}}{\partial r} + \frac{1}{r\Sigma_{\text{g}}} \frac{\partial}{\partial r} \left(rD\Sigma_{\text{g}} \frac{\partial C_{i,\text{sol}}}{\partial r} \right) + S_{\text{cond}} - S_{\text{subl}}$$

$$\frac{\partial C_{i,\text{vap}}}{\partial t} = -v_{\text{g},r}\frac{\partial C_{i,\text{vap}}}{\partial r} + \frac{1}{r\Sigma_{\text{g}}}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD\Sigma_{\text{g}}\frac{\partial C_{i,\text{vap}}}{\partial r}\right) + S_{\text{subl}} - S_{\text{cond}}$$

- *i*:酸素キャリアー分子種 (シリケイト, H₂O)
- Σg:円盤ガス面密度
- D: 乱流拡散係数

… 乱流粘性係数と等しいと仮定. $D=rac{M_{
m disk}}{3\pi\Sigma_{
m g}}$

 $v_{\mathrm{g},r}$: ガス動径速度 … 降着率から決定. $v_{\mathrm{g},r} = rac{\dot{M}_{\mathrm{disk}}}{2\pi r \Sigma_{\mathrm{g}}}$

*v*_{d,r}: ダスト動径速度

… ガス抵抗による落下, 粒径に依存. $v_{\mathrm{d},r} = v_{\mathrm{d},r}(a_{\mathrm{max}}, \Sigma_{\mathrm{g}})$ $S_{\mathrm{cond}}, S_{\mathrm{subl}}$:蒸発位置を境に $C_{i,\mathrm{vap}}$ と $C_{i,\mathrm{sol}}$ を相互に変換.

ダスト動径速度の計算

- 1. 衝突破壊過程を考慮,最大ダストサイズを決定.
 - 乱流の速度からダスト層の厚さを計算. $v_{turb} \sim \alpha c_{s}$
 - 最大サイズ … その高さでの微小ダストとの鉛直相対速度から決定. $v_{d,z} = \min(v_{d,z,H_g}, v_{turb})$ $v_{d,z}(a_{max}) - v_{d,z}(a_{min}) = v_{stick}$
 - 付着限界速度 ... *v*_{stick} ~ 1 m/s (Blum and Schräpler, 2004)
 - サイズ分布 … 大きなダストが支配的なベキ (p = -3.5) を仮定. $n(a) \propto a^p$
 - 最大ダストの速度で代表, 円盤の光学的厚さに影響.
- 2. 動径方向の運動方程式に最大ダストサイズを代入し,計算.

各キャリアーへの〇の配分

	シリケイト	H ₂ O 氷	COガス
凝固点 (K)	1350	160	
O (total = 13)	3	6	4
δ ^{17,18} Osolar (‰)	0	+120	-180

- シリケイトは MgO + SiO₂ として, 太陽組成から計算.
- H₂O 量はシリケイト量と Greenberg (1998) から決定.
 - 初期分別はYK04 に従う, 理論的見積りの下限付近.
- δ^{17,18}O_{solar}は太陽 (分子雲)を基準としたもの.
- δ^{17,18}O_{SMOW} との対応は計算結果から求まる.

降着の減衰に伴う円盤の進化



円盤の酸素同位体組成進化



• 降着率減少後, H₂O/シリケイト蒸気が各蒸発領域で濃集, 徐々に内側へ輸送.

- H₂Oの濃集に伴い, 円盤組成が大局的に¹⁶O-rich → ^{17,18}O-rich へ進化.
- シリケイト蒸発領域に不連続, 円盤内縁に局所的に ¹⁶O-rich な環境.

CAI, コンドリュールの分析値との比較

- コンドリュール主要形成期 : 2.5 Myr 以降
 - $\rightarrow 0 \% @ \delta^{17,18} O_{SMOW}$ $= 70 \sim 90 \% @ \delta^{17,18} O_{solar}$
 - Kobayashi and Yurimoto (2003) のコンド リュール $\delta^{17,18}O_{SMOW}$ = -80 ‰ と調和的.
- CAI とコンドリュールの組成差
 - 2.5 Myr 間で 40 ‰ 以上の変化は, よほど CAI 形成が遅くない限り満たされる.
- コンドリュール間の一様性
 - 空間的にはどの時点でもかなり一様.
 - CAI 形成が << 1Myr だと, コンドリュール 形成期の時間変化大.
 - CAI 形成が 1~2 Myr だと, コンドリュール
 形成期の時間変化小, 分析結果を再現.



まとめ

- 水やシリケイトの濃度変化が同位体組成に与える影響を再検討.
 - H₂O, シリケイトの固・気両相における輸送過程を計算.
 - 衝突破壊による最大ダストサイズの半解析的な見積り.
 - 降着の減衰に伴うガス-ダスト分別の時間変化を考慮.
- コンドライト物質の酸素同位体組成 (In this case...)
 - CAI とコンドリュールの組成差形成
 - 2.5 Myr 間に ~ 40 ‰ 以上の酸素同位体組成差形成.
 - 3~5 Myr の空間的・時間的組成変動小
 - コンドリュール間の一様性 (~ 10 ‰)を再現.
 - 中心星形成の1 Myr 後に CAI 形成が起これば適当.
- どのようなパラメータ範囲 (e.g., 円盤質量, 付着限界速度, 初期分別) で 再現可能かを調べる必要あり.

面密度のベキに対する依存性



• 面密度変化が大きいほど空間的不均質も大きい.

● コンドリュール,惑星物質の一様性を再現できず.

質量降着の減衰率への依存性



- この場合, 依存性はほぼ無し.
 - 重い円盤では,空間不均質が顕著になる.
- 観測的によりリーズナブルな η = 1.5 と調和的.

各キャリアーへの C, O の配分

	シリケイト	H ₂ O 氷	COガス	有機物
凝固点 (K)	1400	160		450
С			6	1
δ ^{17,18} O _{MC} (‰)	0	+120	-80	
Ο	3	4	6	~0



- Nakano et al. (2003) ... 有機物蒸発領域に還元的環境
 - H₂O の濃集により, 必ずしもそうはならない.
- snow line 背面に還元的環境が形成される.